

Zusammenfassung vom 18.11.2011

- npn-Transistor** → zwei Dioden in Reihe geschaltet:
 1) np-Diode in Durchlassrichtung, 2) pn-Diode in Sperrrichtung
- gemeinsame Basis (p-HL) muss so dünn sein, dass für ihre Dicke d_p gilt: $d_B \ll L_{n,p}^B$ $L_{n,p}^B =$ Diffusionslänge in der Basis
- Stromverstärkung $B_N = I_C/I_B \cong 50 - 500$

np-Diode Durchlassrichtung mit Spannung U_{BE}

(vernachlässige Stromverstärkung)

→ Minoritätsladungsträger: $p_n^E = p_n^E(U_{BE} = 0) \left[e^{\frac{eU_{BE}}{kT}} - 1 \right]$ $n_p^B = n_p^B(U_{BE} = 0) \left[e^{\frac{eU_{BE}}{kT}} - 1 \right]$

→ Löcherstrom Basis → Emitter, der exponentiell mit U_{BE} anwächst: $I_B \propto j_{p,BE}^{Diff} = \frac{eD_p^E}{L_p^E} p_n^E(U_{BE} = 0) \left[e^{\frac{eU_{BE}}{kT}} - 1 \right]$

pn-Diode Sperrrichtung mit Spannung U_{CB}

- Minoritätsladungsträger können ungehindert (d.h. unabhängig von U_{CB}) durch die Sperrschicht fließen

→ Sättigungsstrom in Sperrrichtung: $j_{sätt}^{BC} = \frac{eD_p}{L_p} p_n^C + \frac{eD_n}{L_n} n_p^B$

pn-Diode → $j_{\text{sätt}}^{\text{BC}}$ ist proportional zur Konzentration der Minoritätsladungsträger, insbesondere zur Elektronendichte n_p^{B} in der Basis:

$$I_{\text{C}} \propto j_{\text{sätt}}^{\text{BC}} \propto n_p^{\text{B}} \quad \rightarrow \quad I_{\text{C}} \propto n_p^{\text{B}} (U_{\text{BE}} = 0) \left[e^{\frac{eU_{\text{BE}}}{kT}} - 1 \right]$$

→ Kollektorstrom I_{C} nimmt **exponentiell** mit U_{BE} zu

→ Kollektorstrom I_{C} wird durch U_{BE} **gesteuert**

Ursache der Stromverstärkung B_{N} $d_{\text{B}} \ll L_{\text{n,p}}^{\text{B}}$

→ wegen der geringen Dicke der Basisschicht können fast alle Elektronen, die vom Emitter → Basis gelangt sind, zum Kollektor weiterwandern, ohne dass sie in der Basisschicht mit einem Loch rekombinieren

→ stationäres Gleichgewicht für Minoritätsladungsträger n_p^{B} in der Basisschicht wird **verschoben**

→ dies ist gleichbedeutend mit einer erheblich reduzierten effektiven Lebensdauer der Minoritätsladungsträger in der Basisschicht, da diese sehr schnell zum Kollektor diffundieren:

$$L_{\text{n}}^{\text{B}} = \sqrt{D_{\text{n}}^{\text{B}} \tau_{\text{n}}^{\text{B}}} \quad \rightarrow \quad \tau_{\text{n}}^{\text{B}} = \frac{L_{\text{n}}^{\text{B}2}}{D_{\text{n}}^{\text{B}}} \propto L_{\text{n}}^{\text{B}2}$$

effektive Lebensdauer \rightarrow wegen der geringen Dicke der Basisschicht ist die effektive Lebensdauer $\tau_{n,\text{eff}}^B$ in der Basisschicht bestimmt durch die Dicke der Basis:

$$\tau_{n,\text{eff}}^B = d_B^2 / D_n^B \rightarrow \tau_{n,\text{eff}}^B \ll \tau_n^B$$

Rekombinationsrate für n^B

$$\frac{\partial n^B}{\partial t} = -\frac{1}{e} \vec{\nabla} \cdot \vec{j}_{n,\text{BE}}^{\text{Diff}} - \frac{n^B - n_p^B}{\tau_{n,\text{eff}}^B}$$

stationäre Lösung

$$\frac{\partial n^B}{\partial t} = 0 \rightarrow \frac{\partial^2 n^B}{\partial x^2} = \frac{n^B - n_p^B}{D_n^B \tau_{n,\text{eff}}^B} \cong \frac{1}{d_B^2} (n^B - n_p^B)$$

$$\rightarrow n^B(x) = n_p^B \left(1 + e^{-\frac{x}{d_B}} \right)$$

$$\vec{j}_{n,\text{BE}}^{\text{Diff}} = -e D_n^B \frac{\partial n^B(x)}{\partial x} \rightarrow I_C \propto j_{\text{sätt}}^{\text{BC}} \cong j_{n,\text{BE}}^{\text{Diff}} = \frac{e D_n^B}{d_B} n_p^B (U_{\text{EB}} = 0) \left[e^{\frac{eU}{kT}} - 1 \right]$$

Stromverstärkung

$$\rightarrow B_N = \frac{I_C}{I_B} = \frac{j_{\text{sätt}}^{\text{BC}}}{j_{p,\text{BE}}^{\text{Diff}}} \cong \frac{j_{n,\text{BE}}^{\text{Diff}}}{j_{p,\text{BE}}^{\text{Diff}}} = \frac{D_n^B}{D_p^E} \frac{L_p^E}{d_B} \frac{n_p^B (U_{\text{EB}} = 0)}{p_n^E (U_{\text{EB}} = 0)}$$

$$\rightarrow B_N \cong \frac{L_p^E}{d_B} \cong \frac{L_n^B}{d_B} \gg 1 \quad \text{da} \quad \begin{aligned} p_n^E (U_{\text{EB}} = 0) &= n_p^B (U_{\text{EB}} = 0), \\ D_n^B &\cong D_p^E, \quad L_n^B \cong L_p^E \end{aligned}$$

Magnetfeld $\vec{B}_0 = \mu_0 \vec{H}$ *H = magnet. Feldstärke (Hilfsgröße)*
B₀ = äußeres Magnetfeld

Magnetisierung $\vec{M} = \frac{1}{V} \sum_i \vec{\mu}_i \rightarrow \vec{B} = \vec{B}_0 + \mu_0 \vec{M}$ *$\vec{\mu}_i =$ magnet. Dipolmoment*
 $\vec{B} =$ Magnetfeld in Materie

magnetische Suszeptibilität $\chi = \mu_0 \frac{\partial M}{\partial B_0}$ $\chi_{\mu\nu} = \mu_0 \frac{\partial M_\mu}{\partial B_{0\nu}}$ *im Allgemeinen*
Tensor 2. Stufe

diamagnetisch $\chi < 0, \chi \neq \chi(B_0, T) \rightarrow \vec{M} = \chi \frac{1}{\mu_0} \vec{B}_0$ *häufig linearer*
Zusammenhang

paramagnetisch $\chi > 0, \chi \neq \chi(B_0)$

Vektorpotential $\vec{B}_0 = \vec{\nabla} \times \vec{A}, \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \rightarrow \vec{A} = \frac{1}{2} \vec{r} \times \vec{B}_0$ *$\vec{B}_0 =$ konstant*

magn. Bahnmoment $\vec{\mu}_l = -\mu_B \vec{L}$ $\hbar \vec{L} = \hbar \sum_i \vec{l}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$ *Bahndrehimpuls*
(klassisch: Kreisstrom) der Elektronen

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m} = 5.788 \cdot 10^{-5} eVT^{-1} \quad \text{Bohrsches Magneton}$$

magn. Spinmoment $\vec{\mu}_s = -\mu_B g_0 \vec{S}$ $\vec{S} = \sum_i \vec{s}_i$ *Spin der Elektronen*

elektronischer g-Faktor $g_0 = 2 \left[1 + \frac{\alpha}{2\pi} + O(\alpha^2) \right] = 2.0023 \cong 2$ $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c} \cong \frac{1}{137}$

Feinstrukturkonstante

**Gesamtdrehmoment und
gesamtes magnetisches Moment**

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} \quad \rightarrow \quad \vec{\mu} = -\mu_B \vec{J} = -\mu_B (\vec{L} + g_0 \vec{S})$$

Feldimpuls

$$\vec{p}_i \rightarrow \vec{p}_i + e\vec{A}(\vec{r}_i) = \vec{p}_i - \frac{e}{2} \vec{r}_i \times \vec{B}_0$$

**Hamiltonoperator im äußeren Magnetfeld
(ohne Spin)**

$$H = \frac{1}{2m} \sum_i [\vec{p}_i^2 + e\vec{A}(\vec{r}_i)]^2$$

$$\rightarrow H = \frac{1}{2m} \vec{p}^2 + \mu_B \vec{L} \cdot \vec{B}_0 + \frac{e^2}{8m} B_0^2 \sum_i (x_i^2 + y_i^2) \quad \vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z$$

Hamiltonoperator mit Spin $H_s = -\vec{m}_s \cdot \vec{B}_0 = \mu_B g_0 \vec{S} \cdot \vec{B}_0$

$$\rightarrow H = H_0 + H_{\text{int}} \quad H_0 = \frac{1}{2m} \vec{p}^2$$

$$\rightarrow H_{\text{int}} = \mu_B (\vec{L} + g_0 \vec{S}) \cdot \vec{B}_0 + \frac{e^2}{8m} B_0^2 \sum_i (x_i^2 + y_i^2)$$

**Störungstheorie
(1. und 2. Ordnung)**

$$\Delta E_n = \langle n | H_{\text{int}} | n \rangle + \sum_{n' \neq n} \frac{|\langle n | H_{\text{int}} | n' \rangle|^2}{E_n - E_{n'}}$$

$$\rightarrow \Delta E_n = \mu_B \vec{B}_0 \cdot \langle n | \vec{L} + g_0 \vec{S} | n \rangle + \sum_{n' \neq n} \frac{|\langle n | \mu_B \vec{B}_0 \cdot (\vec{L} + g_0 \vec{S}) | n' \rangle|^2}{E_n - E_{n'}} + \frac{e^2}{8m} B_0^2 \langle n | \sum_i (x_i^2 + y_i^2) | n \rangle$$

*Langevin
Paramagnetismus*

*Van-Vleck-
Paramagnetismus*

*Langevin
Diamagnetismus*